

高温老化对不同氧化层厚度的 PMOS 剂量计探头的影响

Tuesday, 16 October 2018 14:15 (15 minutes)

PMOS 剂量计的工作环境温度一般不同于我们地面标定的环境温度，PMOS 剂量计的敏感探头是 PMOSFET 半导体器件，其阈值电压的受温度的影响较为敏感。因此，了解 PMOS 剂量计探头的温度效应，对提高 PMOS 剂量计测量准确度和拓展使用环境范围至关重要。本论文对常用探头进行了辐照前的老化试验，通过试验获得温度对器件敏感参数的影响规律，分析温度对探头响应特性的影响规律，以及缺陷的影响机理，为寻找提高 PMOS 剂量测量稳定性的方法提供数据和理论支持。

Primary author: Mrs 孙, 静 (中国科学院新疆理化技术研究所)

Presenter: Mrs 孙, 静 (中国科学院新疆理化技术研究所)

Session Classification: 第一分会场 (3)

Track Classification: 核探测器及其应用的研究成果